

电剖面曲线图册

(内部资料)



地质部水文地质工程地质局

內 容 提 要

本書首先介紹了不同裝置及不同條件下的電場特征。內容包括聯合剖面，偶極剖面，對稱剖面及中間梯度剖面，在接觸面、厚板、薄板、地形及組合斷面上的正問題曲綫和部分實例。另外，在附錄中還介紹了對電剖面曲綫的定量解釋，地形校正方法，組合斷面曲綫的簡易構制方法和各種模型實驗方法。

本書可供從事電法勘探的野外工程技術人員參考，也可供科技人員和專科學校有關人員閱讀。

電 剖 面 曲 綫 圖 冊

(內部資料)

*

地質部水文地質工程地質局第四大隊編

1967年6月

*

開本：25 印數：0001—4000

毛主席语录

人类的历史，就是一个不断地从必然王国向自由王国发展的历史。这个历史永远不会完结。在有阶级存在的社会内，阶级斗争不会完结。在无阶级存在的社会内，新与旧、正确与错误之间的斗争永远不会完结。在生产斗争和科学实验范围内，人类总是不断发展的，自然界也总是不断发展的，永远不会停止在一个水平上。因此，人类总得不断地总结经验，有所发现，有所发明，有所创造，有所前进。停止的论点，悲观的论点，无所作为和骄傲自满的论点，都是错误的。其所以是错误，因为这些论点，不符合大约一百万年以来人类社会发展的历史事实，也不符合迄今为止我们所知道的自然界（例如天体史，地球史，生物史，其他各种自然科学史所反映的自然界）的历史事实。

序 言

近年来，为适应我国社会主义建设和国防建设的需要，做了大量的物探工作，起了很大作用。尤其在水文地质工程地质勘探、寻找金属矿产中，目前电剖面法应用十分广泛。但因为山区地形切割剧烈，地质条件较复杂，干扰因素多，在解释资料时，遇到许多困难。实践证明，往往由于正演概念不够清楚，对各种地质断面的异常特征认识不清，解释水平赶不上实际的需要，因而影响了物探效果的充分发挥。

迄今，国内外针对不同的地质问题，对不同装置的电剖面法，已做了大量的理论计算、模型实验和实践工作，积累了丰富的资料。但这些资料，绝大部份还是另星分散，没有经过系统的总结归纳，有时在说法上亦不一致，符号也不统一，对广大野外人员不但使用不便，也难以得到了解和利用，在一定程度上，影响了对取得资料的深入解释。尤其在水文地质工程地质勘探中，往往地形地质条件都较复杂，为了合理使用电剖面法，并能从复杂的异常中判别有用异常，提高解释水平，据我们近年来工作中的体会，将目前国内外在电剖面工作实践中，所取得的各种曲线，加以归纳整理，对一些相互有出入的提法及错漏的地方，尽量作了修正，统一了符号，汇编成这本图册。便于野外从事电法工作的同志分析比较，更好地掌握利用，有目的地进行模型实验，合理地进行推断解释，以便在充分利用已有成果的基础上，有所发现，有所发明，有所创造，有所前进。这就是编此图册的目的。

图册力求实用，图的顺序是按地质问题，从简到繁排列的。虽然野外所遇到的地质问题千变万化，各不相同，但按其地球物理条件划分，大体属于接触面、厚板、薄板、球体和半球体、地形影响等断面及其组合六类。如坚硬緻密岩石的破碎带，当充水后，相当于一良导的厚板或薄板体；断层相当于一个接触面；岩溶溶洞相当于球或半球体等，不一而足。在每一类型的断面上，按地质体为良导体和非良导体、直立和倾斜、依次以联合剖面、偶极剖面、对称剖面、中间梯度等方法分别叙述。在每一断面的开始，尽可能详细地分析其典型曲线（ $H=0$ ， $\varphi=90^\circ$ ， $\alpha=90^\circ$ 时的曲线）的特征，以便于更好地去认识这种断面的非典型曲线。

为了避免重复，各图的符号，除个别地方单独说明外，均在本图册之首页统一说明，不在每图下边反复叙述。同时，在各图註中，凡沒有注明 H 及 φ 者，均表示 $H=0$ ， $\varphi=90^\circ$ 。沒有注明 L 及 d 者，均表示其为趋于无限大的二度体。至于对各曲线特点的说明，也只分析其主要特征。

在水文地质工程地质勘探中，经常要求对物探结果，作出定量的解释。但目前国内外对电剖面的解释中，多以定性为主，定量解释的经验还不多，有时由于地形干扰的影响，甚至连定性解释也很困难。但为了适应勘探的需要，还是尽量将目前求地质体产状埋深等的定量解释方法、地形改正方法及模型实验方法，进行归纳后，作为附录，放在图册的最后。以便有条件时作必要的地形改正、模型实验和定量解释。

图册的内容，基本包括 1932 年来国内外（以国内为主）所见的联合剖面、偶极剖面、对称剖面、中间梯度剖面的理论和实验曲线。並顺便介绍了板状体上的平移剖面曲线，半球体上的五极剖面（Lee 装置）曲线，以作参考。

图册中的曲线，以实验曲线居多，由于实验条件的局限性，故曲线的一些特征，是否属一般规律，尚需在实践中验证。因为“一个正确的認識，往往需要經過由物质到精神，由精神到物质，即由实践到認識，由認識到实践这样多次的反复，才能够完成”。只有按照毛主席这个教导，才能更好地认识客观规律，从必然王国向自由王国发展。

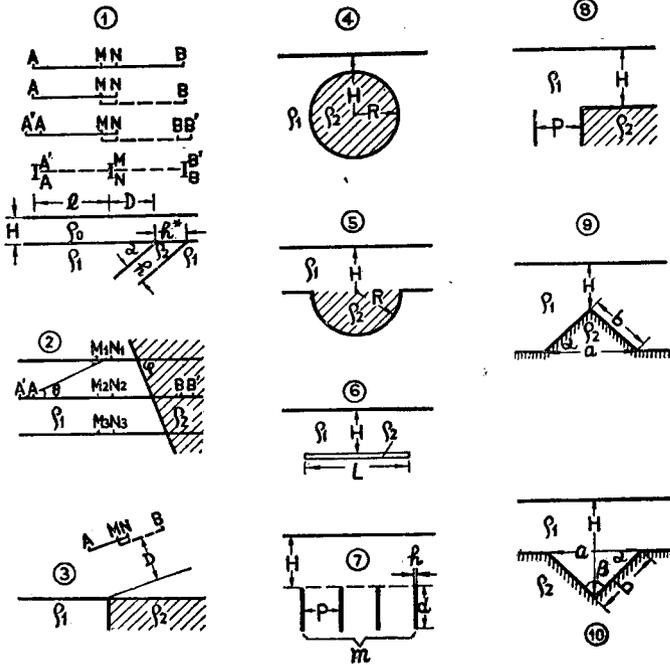
最后，由于我们工作者的思想水平和工作能力所限，一定还有很多资料沒有总结进来，更可能出现不少的缺点和错误。所以，这本图册所介绍的内容，还是很粗糙的，尚待同志们批评指正，並在大量的实践中，去粗存精，去伪存真，将其丰富和提高。

目 录

| | |
|---------------|-----|
| 序 言 | |
| 符号说明 | 1 |
| 一、接 触 面 | |
| (一) 直立接触面 | 6 |
| (二) 倾斜接触面 | 18 |
| 二、厚 板 | |
| (一) 良导直立厚板 | 33 |
| (二) 非良导直立厚板 | 39 |
| (三) 良导倾斜厚板 | 46 |
| (四) 非良导倾斜厚板 | 53 |
| 三、薄 板 | |
| (一) 良导直立薄板 | 59 |
| (二) 非良导直立薄板 | 78 |
| (三) 良导倾斜薄板 | 91 |
| (四) 非良导倾斜薄板 | 103 |
| 四、球体和半球体 | |
| (一) 良导球体 | 114 |
| (二) 非良导球体 | 119 |
| (三) 半球体 | 121 |
| (四) 水平圆柱体 | 131 |
| 五、各种装置异常特点的对比 | 133 |
| 六、地 形 | |
| (一) 阶梯地形 | 135 |
| (二) 山脊地形 | 137 |
| (三) 山谷地形 | 142 |
| (四) 组合地形 | 152 |
| (五) 隐伏地形 | 154 |

| | |
|--------------------------------|-----|
| (六) 地形影响的因素····· | 159 |
| 七、組合断面 | |
| (一) 在接触面上的良导与非良导体····· | 161 |
| (二) 平行板的組合····· | 169 |
| 1. 平行排列的良导薄板····· | 169 |
| 2. 平行排列的非良导薄板····· | 171 |
| 3. 平行的良导与非良导体的組合····· | 174 |
| 4. 倾斜板状体的組合····· | 195 |
| (三) 組合球体····· | 202 |
| (四) 地形与地质体的組合····· | 203 |
| 附录一：确定地质体位置埋深及产状的方法 | |
| (一) 确定介面位置····· | 223 |
| (二) 确定倾向和倾角····· | 224 |
| (三) 求走向长度(L)的方法····· | 231 |
| (四) 求延深(d)的方法····· | 233 |
| (五) 确定地质体埋深(H)的方法····· | 235 |
| 附录二：构制复杂断面曲线的简易方法 ····· | 239 |
| 附录三：地形校正方法 | |
| (一) E量板法····· | 241 |
| (二) 用模型实验结果校正····· | 248 |
| (三) ρ_s 比值法 (F法)····· | 253 |
| (四) 大极距的 ρ_s 差值法····· | 256 |
| (五) 要注意的问题····· | 256 |
| 附录四：模型实验方法 | |
| (一) 薄水层 (或导电纸) 模型实验····· | 259 |
| (二) 土槽模型实验····· | 262 |
| (三) 等位线模型实验····· | 264 |
| (四) 电模拟实验····· | 266 |
| 附录五：地形校正数据 ····· | 272 |
| 参考文献 ····· | 287 |

符号说明



h : 地质体的厚度。

h^* : 地质体的视厚度 (即出露厚度)。

L : 地质体沿走向的长度。

d : 地质体沿倾向的延伸长度。

H : 地质体的埋藏深度。

α : 地质体的倾角或地形的坡角 (以反时针计算)。

R : 球状地质体的半径。

P : 两地质体间的距离。

m : 几个行平排列地质体的总厚度。

β : 山谷 (山脊) 的底 (顶) 角。

a : 山谷 (山脊) 的宽度。

b : 山谷 (山脊) 的坡长。

ρ_s : 视电阻率。

$\rho_s^{\max}(\rho_s^{\min})$: ρ_s 的极大(极小)值。

ρ_0 : 复盖层的电阻率。

ρ_0' : 正常场电阻率。

ρ_1 : 围岩的电阻率。

ρ_2 : 地质体的电阻率。

l : 极距长度 ($AB/2$ 或 OO' ; l_1 及 l_2 分别为偶极装置的 AO 和 $A'O$)。

l^* : 最佳极距长度。

φ : 地质体走向与剖面的夹角。

θ : 测量与供电偶极子中心连线与剖面的夹角。

D : 测量中心与地质体边界的距离。

X : 测量中心与地质体中心的距离。

η : 异常幅度 $\eta = \frac{\rho_s^{\max} - \rho_s^{\min}}{\rho_0'} \times 100\%$

η^* : 异常值 $\eta^* = \frac{\rho_s^{\max\min} - \rho_0'}{\rho_0'} \times 100\%$

j : 电流密度。

E : 电势强度。

I : 电流强度。

不同装置类型、装置大小及复盖层电阻率，对电场和视电阻率有很大的影响，根据其在不同情况下的特点，可选择合适的工作方法。

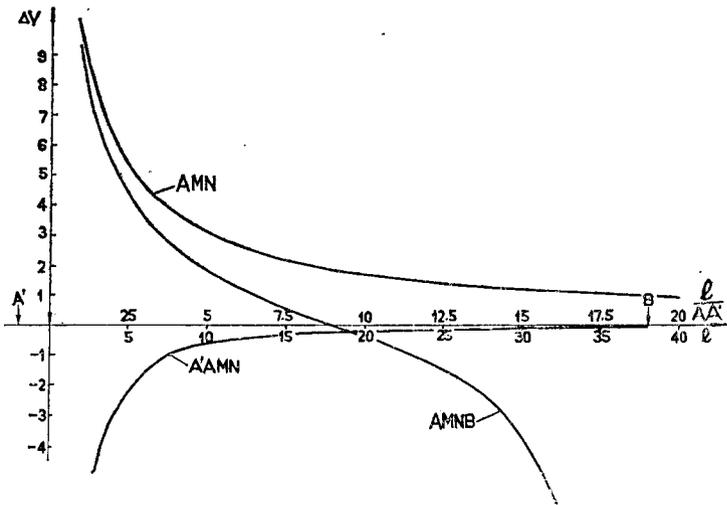


图1 在均匀各向同性半空间中，不同装置的电位曲线。
 ($\frac{\rho_1}{2\pi} = 37$)。↓：供电极位置($A'A = MN = 1$)

由图1看出：

(1) 偶极装置的电场衰减最快，三极装置最慢。

(2) 偶极装置的均匀电场位于： $\frac{l}{AA'} \geq 5$ 。

三极装置的均匀电场位于 $l/MN > 10$ 。

(3) 要使曲线反映出不均匀体的异常，必须使测量电极位于均匀电场之中。

(图2) $l=H$ 时， ρ_s 与 ρ_0 仍然相差很少。当 $l > 2H$ 时， ρ_s 才开始对 ρ_s 值起影响。 $l=10H$ 时， $\rho_s \sim \rho_1$ 。

对于 $\rho_1 > \rho_0$ 的断面，随着比值 ρ_1/ρ_0 的增大，需要较大的装置(l)， ρ_s 才能趋近 ρ_1 ($\rho_1/\rho_0 = 2$, $l = 10H$; $\rho_1/\rho_0 = 10$, $l = 100H$)。

因此，其他条件相同时，良导复盖层对 ρ_s 的影响，比非良导复盖层大。

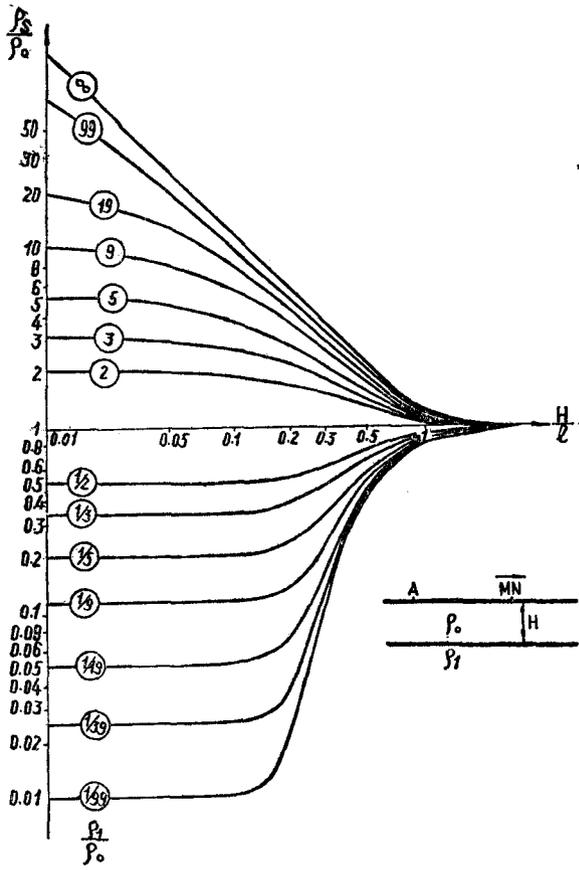


图2 复盖层电阻率(ρ_0)不同时, AMN 装置的 ρ_s 与埋深(H)之关系曲线。

在(图3) $MN \leq h$ 时, ρ_s 与 MN 大小关系不大。在 $MN > h$ 时, 随 MN 的增大, ρ_s 急剧减小。

ρ_1 与 ρ_2 电性差异越小, ρ_s 随电极距(l)变化越小。

对于良导体, 也具有类似的性质。

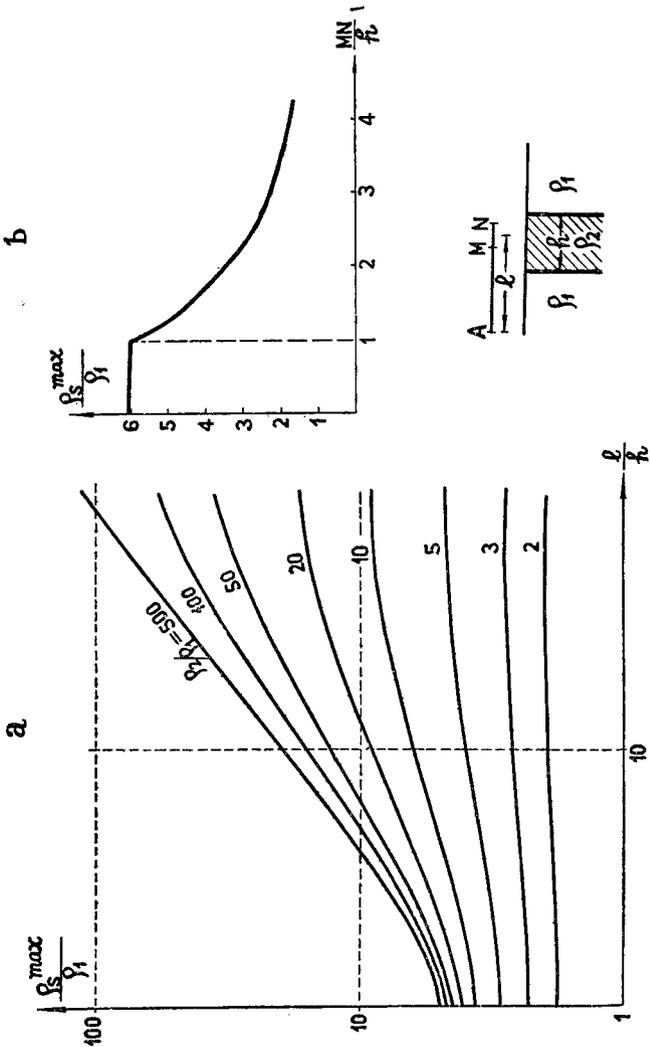


图3 在非良导电板上, AMN装置的 ρ_s 值与电极距的关系。(L=a \rightarrow ∞)
 a: $\rho_s^{max}/\rho_1 = f(\frac{l}{h})$, ρ_2/ρ_1 为参数。 b: $\rho_s^{max}/\rho_1 = f(\frac{\rho_s^{max}}{\rho_1})$; $l = 10h$; $\rho_2 = 10\rho_1$

一、接 触 面 $(h > 2-3l)$

(一) 直 立 接 触 面

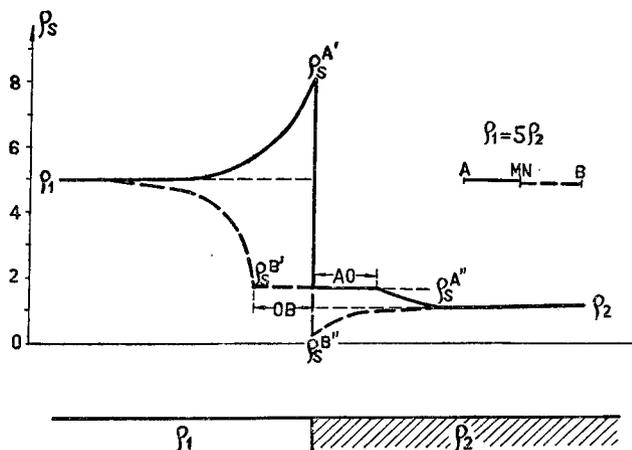


图 4 在直立接触面上的联合剖面曲线。

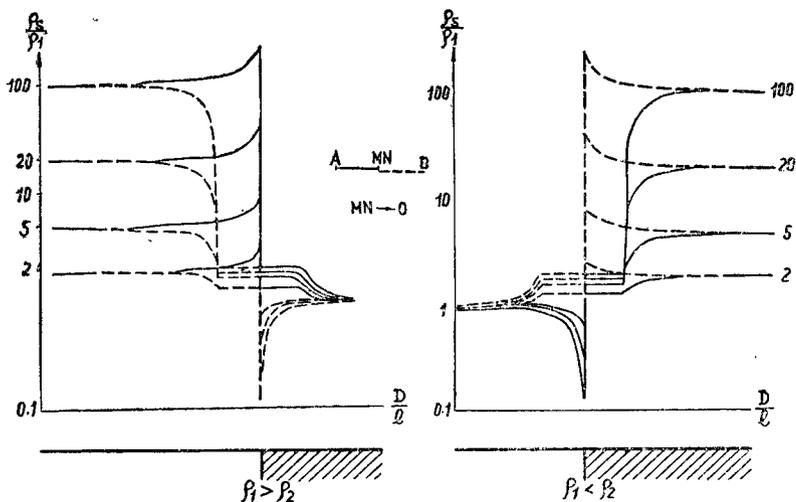


图 5 在电阻率(ρ_2/ρ_1)不同的直立接触面上的联合剖面曲线。

从图 4 得知:

对于 ρ_s^A 曲线: 从 MN 通过接触面, 到 A 通过接触面为止, ρ_s 保持不变, 其值:

$$\rho_s^{A''} = \frac{2\rho_1 \cdot \rho_2}{\rho_1 + \rho_2}$$

同时, 在接触面上, ρ_s 跃变值有下列关系:

$$\frac{\rho_s^{A'}}{\rho_s^{A''}} = \frac{\rho_1}{\rho_2}$$

当 $\rho_2 \ll \rho_1$ 时: $\rho_s^{A'} \rightarrow 2\rho_1$, $\rho_s^{A''} \rightarrow 2\rho_2$ 。

对于 ρ_s^B 曲线: $\rho_s^{B'} = \frac{2\rho_1 \cdot \rho_2}{\rho_1 + \rho_2}$

$$\rho_s^{B''} = \frac{2\rho_2^2}{\rho_1 + \rho_2}$$

当 $\rho_2 \ll \rho_1$ 时: $\rho_s^{B'} \rightarrow 2\rho_2$

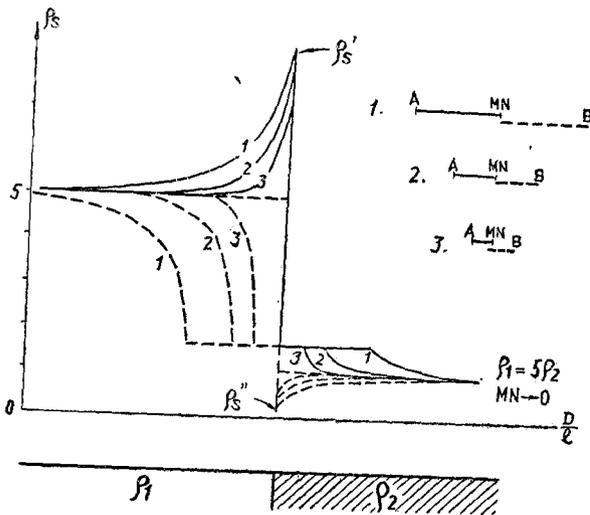


图 6 在直立接触面上, 电极距(l)不同的联合剖面曲线。

ρ_s 在特征点上的大小 (ρ_s' , ρ_s'') 与 l 无关。随 l 的增大, 只增大接触面对 ρ_s 曲线的影响范围。

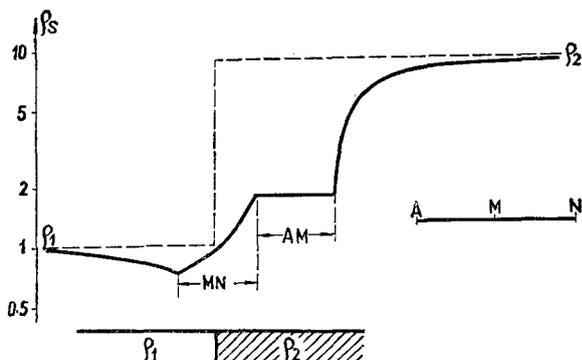
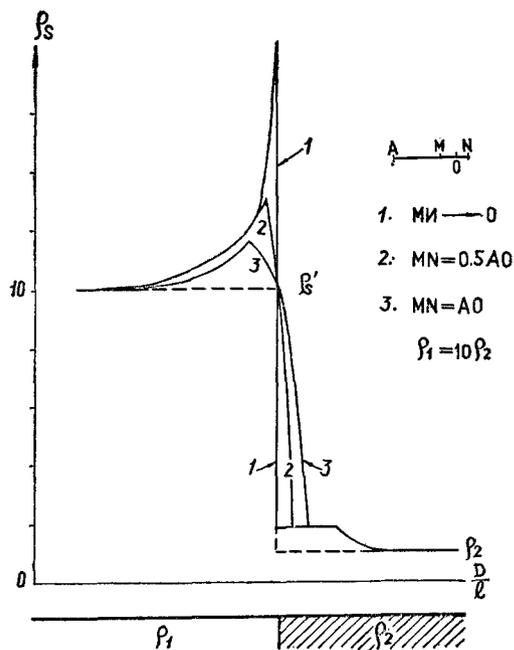


图7 在直立接触面上 MN 不同的联合剖面曲线。

(图7) $\rho_1 > \rho_2$ 时: MN 增大, ρ_s^{\max} 减小, 极大点相对接触面位移了 $MN/2$ 的距离。对应接触面上的 ρ_s 值 (ρ_s') 等于 ρ_1 。

$\rho_1 < \rho_2$ 时: 和上述情形类似。所不同的是随 MN 的增大, 极小点不明显。

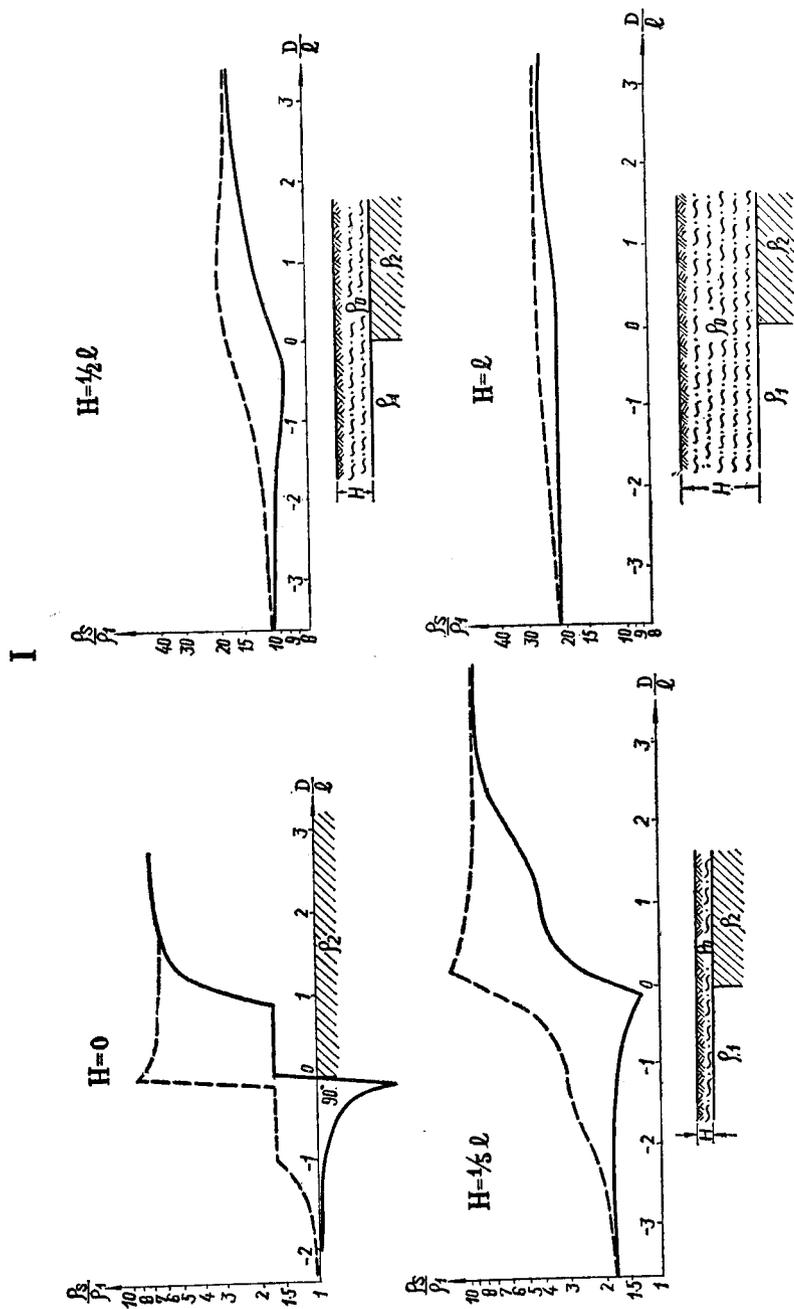


图 8 在复盖厚度(H)不同的直立接触面上的联合剖面曲线。

I: $\rho_0=30, \rho_1=1, \rho_2=7\Omega M$

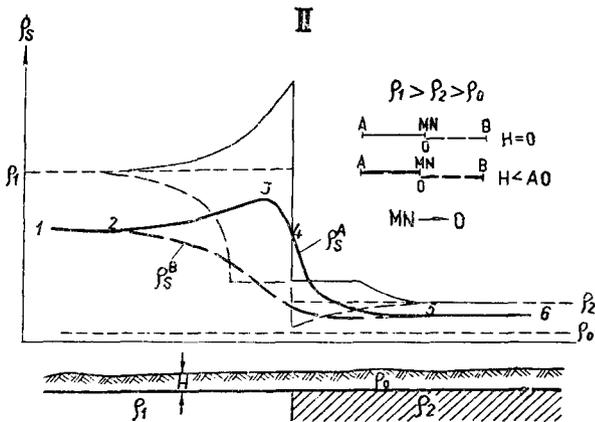


图8 在复盖厚度(H)不同的直立接触面上的联合剖面曲线。

II: $\rho_1 > \rho_2 > \rho_0$

上图当 $H \approx 0$, $\rho_1 > \rho_2$ 的情况下, 正曲线的特征点较反曲线明显。
 $\rho_1 < \rho_2$ 时, 则相反。

接触面的位置, 在 ρ_s^A 曲线陡坡上 $\frac{1}{3}$ 的地方(位置“4”), 或在 ρ_s^B 曲线上升的起点。

极大点“3”, 在离开接触面往 ρ_1 方向移动 $\frac{1}{2}MN$ 处。在离接触面相当远(大于 $2 \sim 3l$) 的“1”—“2”及“5”—“6”段上, H 越大, ρ_s 越接近 ρ_0 。

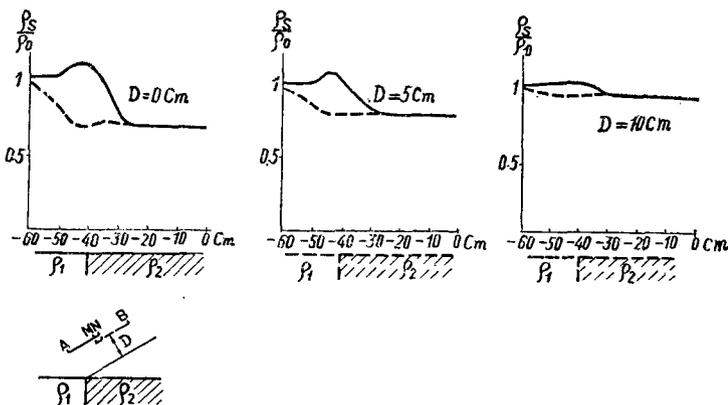


图9 平行直立接触面走向, 距接触线不同距离(D)的联合剖面实验曲线。

$\varphi = 0$; $L = 80\text{Cm}$; $d = 40\text{Cm}$; $H = 5\text{Cm}$; $l = 10\text{Cm}$